

فصل ۱:

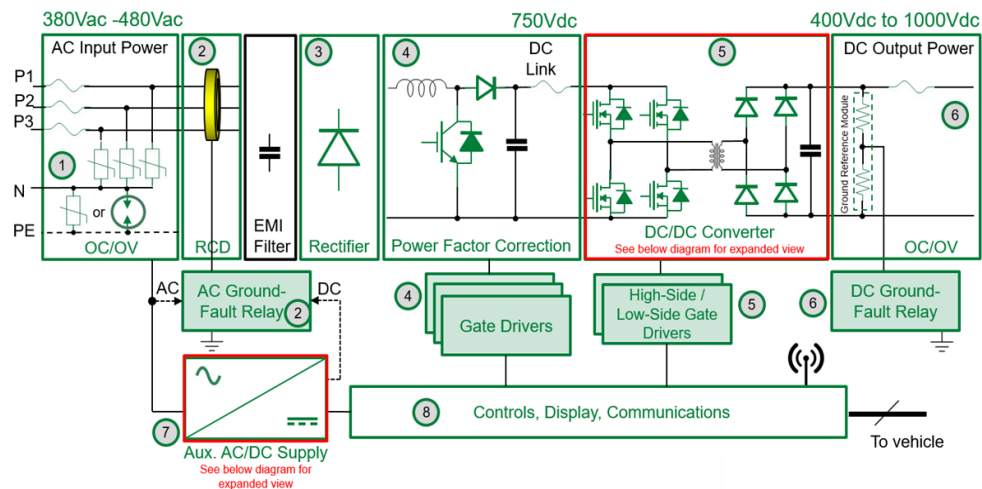
مقدمات، آشنایی با مفاهیم الکترونیک قدرت و نرم افزار

PSpice

۱-۱- معرفی نرم افزارهای SPICE، PSpice و Capture

۱-۲- کلیدها در Pspice (کلید کنترل شده با ولتاژ، دیودها، ترانزیستورها، تایریستورها)

۱-۳- مشکلات همگرایی در PSpice



۱-۱- معرفی نرم افزارهای SPICE، PSpice و Capture

□ شبیه سازی کامپیوتری ابزار تحلیل و طراحی ارزشمندی است که در سراسر این کتاب مورد تأکید قرار دارد. SPICE یک برنامه شبیه سازی مدار است که در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی توسعه یافته است. PSpice یک نسخه تجاری قابل دسترس از SPICE است که برای کامپیوترهای شخصی تهیه شده است. Capture یک برنامه واسط گرافیکی است که اجازه می دهد که شبیه سازی از روی یک نمایش گرافیکی از دیاگرام مدار اجرا شود. شرکت Cadence محصولی به نام OrCAD Capture را ارائه می دهد که نسخه آزمایشی آن رایگان است. تقریباً تمام شبیه سازی های این کتاب توسط نسخه آزمایشی، قابل اجرا می باشند.

✓ بسته به هدف شبیه سازی، در سطوح مختلفی از مدل سازی قطعات و المان ها، می توان شبیه سازی را اجرا کرد. بیشتر مثال های شبیه سازی و تمرین ها، از مدل ایده آل یا مدل پیش فرض استفاده می کنند که با تقریب ابتدایی نتایج را ایجاد می کنند. این همان کاری است که در کارهای تحلیلی اولیه در مورد موضوعات هر کتاب درسی انجام می شود. یک مهندس می تواند پس از فراگیری عملکرد پایه یک مدار الکترونیک قدرت، جزئیات مدل قطعات را برای یک رسیدن به پیش بینی دقیق تر از رفتار یک مدار واقعی در نظر بگیرد.

✓ Probe یک برنامه کمک پردازشی گرافیکی بسیار سودمندی است که همراه PSpice عرضه می شود. در Probe شکل موج هر ولتاژ یا جریان مدار می تواند به صورت گرافیکی نمایش داده شود. این برنامه دید خوبی از رفتار مدار به دانشجو می دهد که در تحلیل با قلم و کاغذ امکان پذیر نیست. علاوه بر این، Probe توانایی محاسبات ریاضی که جریان ها و ولتاژها را در برداشته باشد، مانند محاسبه مقدار مؤثر (RMS) یا مقدار متوسط را داراست.

✓ مثال هایی از تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک قدرت در تمامی بخش های این کتاب وجود دارد. فایل های مداری PSpice که در این کتاب آمده است توسط نسخه ۱۶/۰ ایجاد شده اند. در نسخه های متوالی نرم افزار، به روزرسانی هایی در روش های شبیه سازی ایجاد می شود.

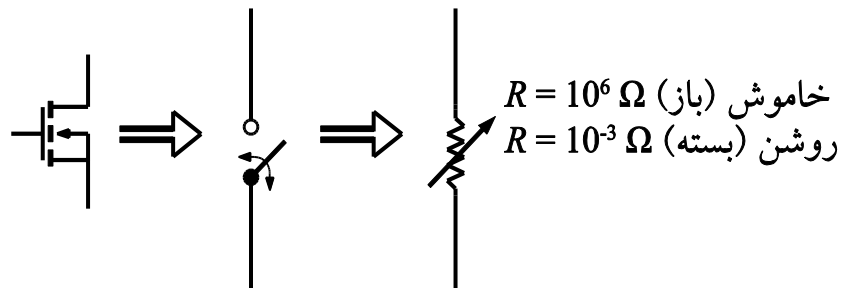
۱-۲- کلیدها در PSpice

کلیدهای کنترل شده با ولتاژ

□ کلید کنترل شده با ولتاژ Sbreak در PSpice به عنوان یک مدل ایده آل برای بیشتر قطعات الکترونیکی قابل استفاده است. شکل ۱-۱ موضوع استفاده از یک مقاومت کنترل شده، به عنوان کلید در شبیه سازی مدارات الکترونیک قدرت در PSpice، را نشان می دهد.

□ یک MOSFET یا هر قطعه کلیدزنی دیگر، در حالت ایده آل یک کلید بسته یا یک کلید باز است. یک مقاومت بزرگ یک کلید باز و یک مقاومت کوچک یک کلید بسته را تقریب می زند. مشخصه های مدل کلید به صورت زیر هستند.

مشخصه	توصیف	مقدار پیش فرض
RON	مقاومت حالت "روشن"	۱ (این مقدار را به ۰/۰۰۱ یا ۰/۰۱ اهم کاهش دهید)
ROFF	مقاومت حالت "خاموش"	$10^6 \Omega$
VON	ولتاژ کنترل برای حالت روشن	۱/۰ V
VOFF	ولتاژ کنترل برای حالت خاموش	۰ V



□ با کنترل ولتاژ، مقاومت از بزرگ به کوچک تغییر می کند. مقدار پیش فرض مقاومت حالت خاموش $1M\Omega$ است که در مدارهای الکترونیک قدرت تقریب خوبی از یک مدار باز می باشد. مقدار پیش فرض مقاومت 1Ω برای حالت روشن، معمولاً خیلی بزرگ است. اگر کلید بخواهد ایده آل باشد، مقاومت حالت روشن در مدل کلید باید به مقدار بسیار کوچک تری مانند 0.001Ω یا 0.01Ω تغییر یابد.

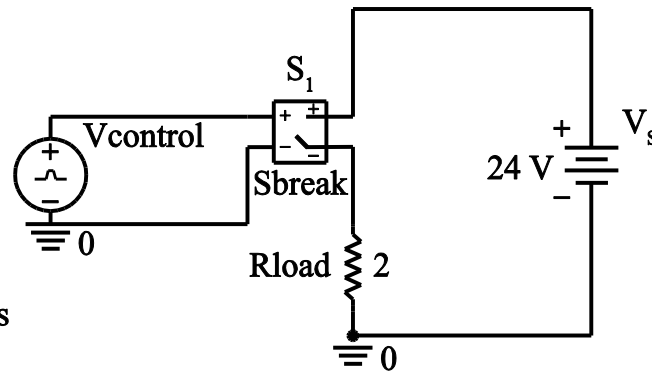
شکل ۱-۱- پیاده سازی یک کلید با مقاومت در PSpice.

□ مثال ۱-۱- کلید کنترل شده با ولتاژ در PSpice

نمودار برنامه Capture برای یک مدار کلیدزنی، در شکل ۱-۲-الف نشان داده شده است. کلید، توسط کلید کنترل شده با ولتاژ Sbreak که در کتابخانه Breakout قرار دارد، پیاده‌سازی شده است. ولتاژ کنترل VPULSE است و از مشخصه نشان داده شده استفاده می‌کند. V1 و V2 سطوح ولتاژهای روشن و خاموش کردن کلید را نشان می‌دهند که به صورت پیش فرض روی ۰V و ۱V تنظیم شده‌اند. دوره کلیدزنی ۲۵ms است که متناظر با فرکانس ۴۰kHz می‌باشد. مدل PSpice برای Sbreak با کلیک کردن روی *edit* و سپس *PSpice model* قابل دسترسی است. پنجره ویرایشگر مدل در شکل ۱-۲-ب نمایش داده شده است. مقدار مقاومت حالت روشن به 0.001Ω تغییر کرده است تا کلید ایده‌آل تقریب زده شود. منوی تحلیل حالت گذرا از بخش Simulation Setting قابل دسترسی است. همان‌گونه که در شکل ۱-۲-۱-ج نشان داده شده، زمان اجرای شبیه‌سازی $80\mu s$ است. در شکل ۱-۲-د، خروجی Probe، شامل ولتاژ کنترل کلید و همچنین شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت بار، نشان داده شده است.

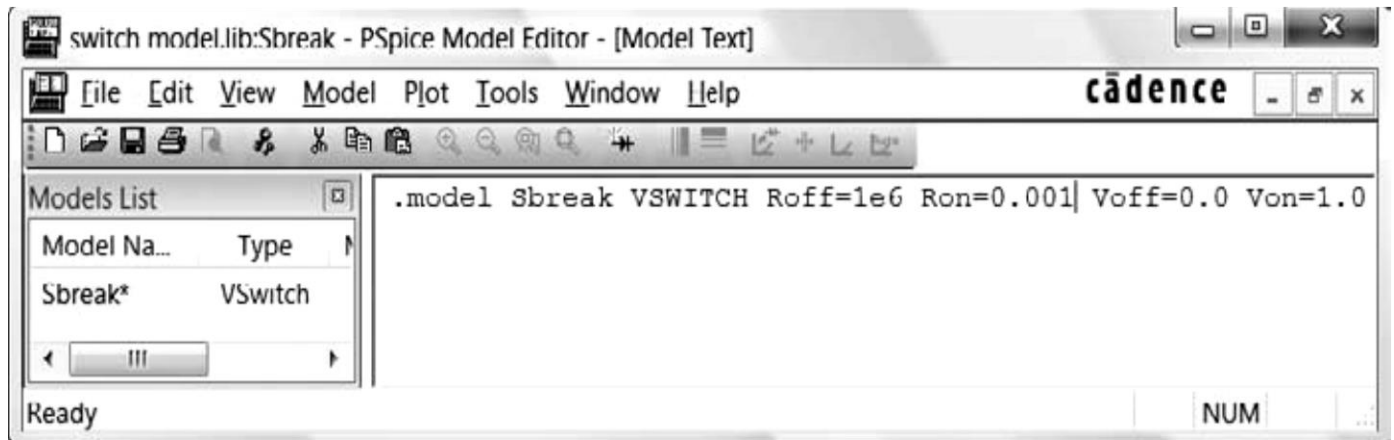
VPULSE

V1 = 0
 V2 = 5
 TD = 0
 TR = 1n
 TF = 1n
 PW = 10us
 PER = 25us

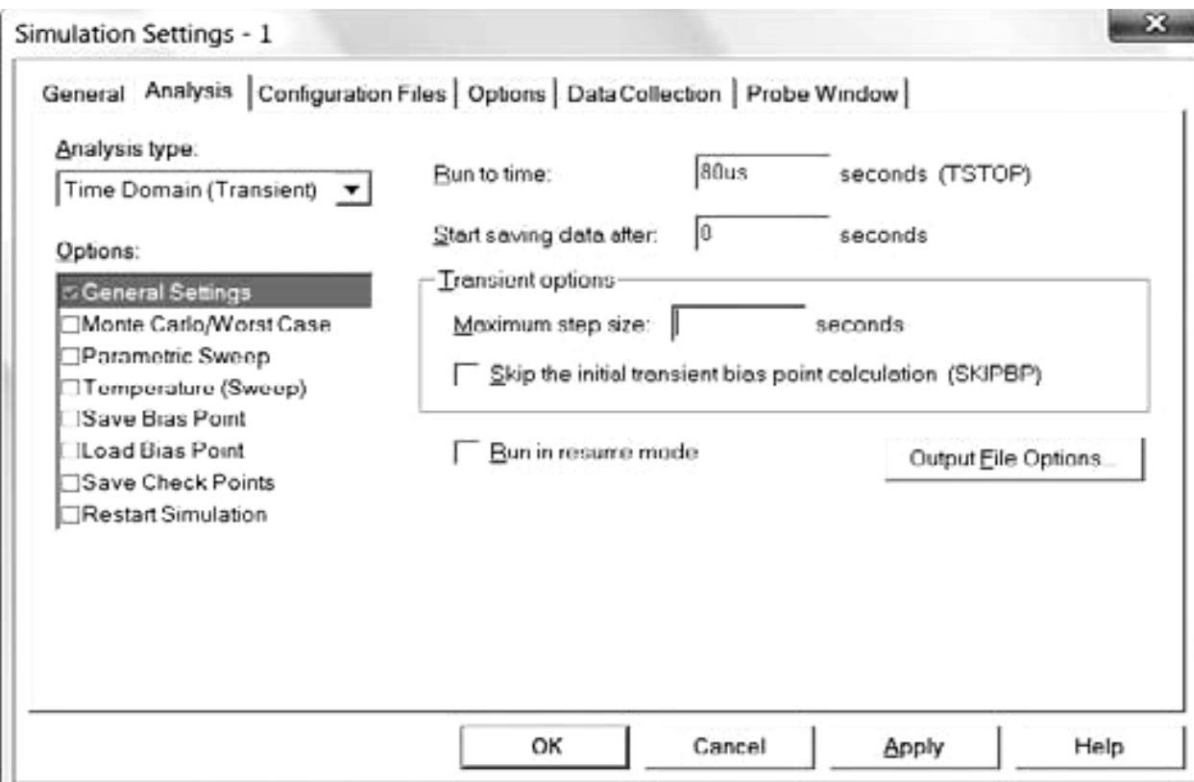


(الف)

شکل ۱-۲-الف) مدار برای مثال ۱-۱-ب) ویرایش مدل کلید Sbreak در PSpice با قرار دادن $R_{on}=0.001\Omega$ ، ج) تنظیم تحلیل حالت گذرا (د) خروجی Probe (ادامه دارد).

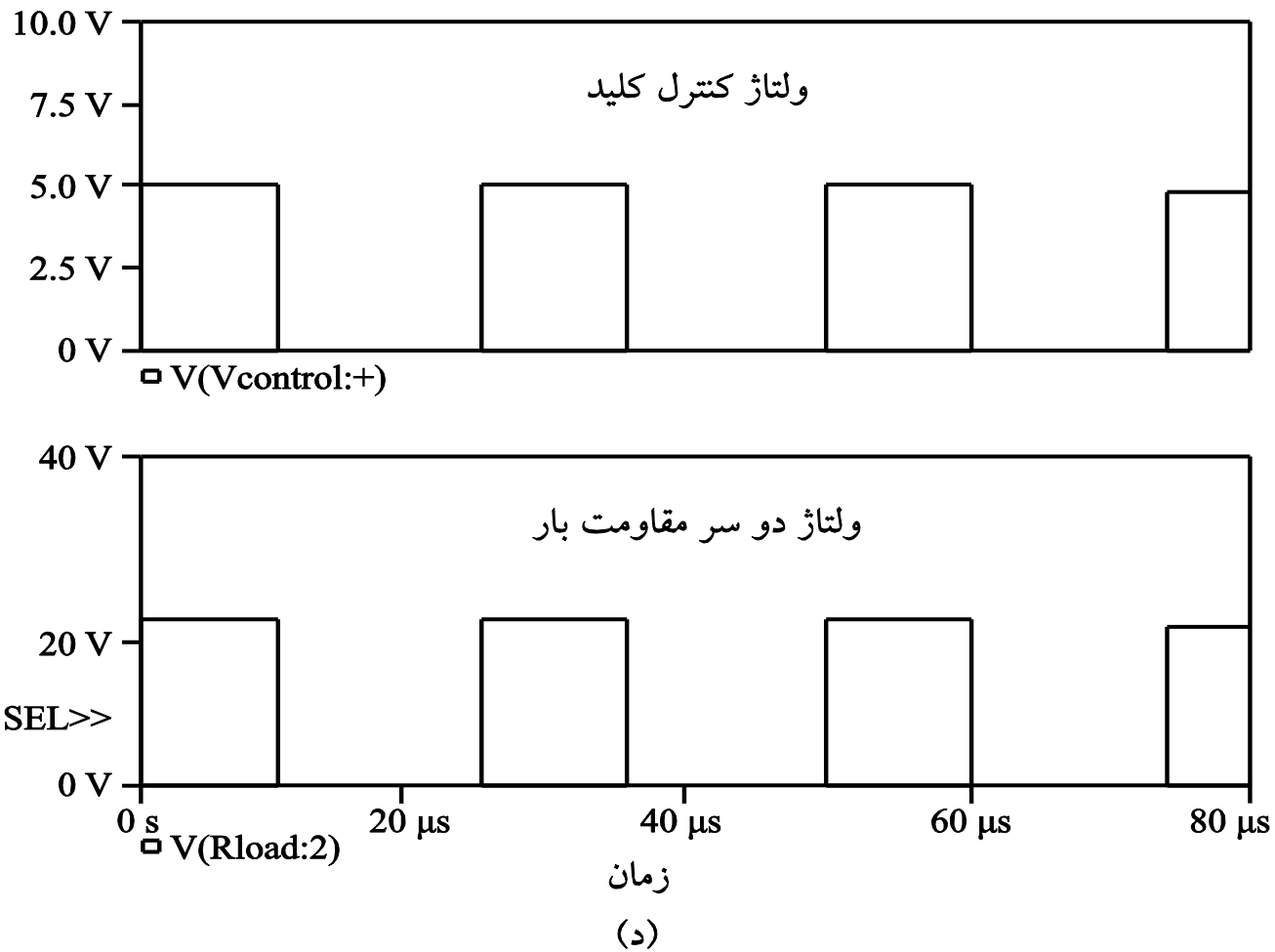


(ب)



(ج)

شکل ۱-۲-الف) مدار برای مثال ۱-۱، ب) ویرایش مدل کلید Sbreak در PSpice با قرار دادن $R_{on}=0.1\ \Omega$ (ج) تنظیم تحلیل حالت گذرا (د) خروجی Probe (ادامه دارد).



شکل ۱-۲-الف) مدار برای مثال ۱-۱، ب) ویرایش مدل کلید Sbreak در PSpice با قرار دادن $R_{on}=0/1 \Omega$ ، ج) تنظیم تحلیل حالت گذرا (د) خروجی Probe (ادامه دارد).

□ ترانزیستورهایی که به عنوان کلید در مدارهای الکترونیک قدرت به کار می‌روند، می‌توانند به عنوان کلید ایده‌آل، توسط کلید کنترل شده با ولتاژ، در شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گیرند. همانند مثال ۱-۲ یک ترانزیستور ایده‌آل می‌تواند در حالت روشن با یک مقاومت بسیار کوچک مدل شود. یک مقاومت حالت روشن که با مشخصات MOSFET تطابق داشته باشد، می‌تواند برای شبیه‌سازی مقاومت هدایت $R_{DS(ON)}$ یک MOSFET مورد استفاده قرار گیرد تا رفتار یک مدار با مشخصه‌های غیر ایده‌آل را تعیین کند. اگر عملکرد دقیق یک ترانزیستور مورد نیاز باشد، ممکن است یک مدل در کتابخانه PSpice یا از پایگاه اینترنتی شرکت سازنده قطعات در دسترس باشد.

□ مدل MOSFET های قدرت IRF150 و IRF9140 در کتابخانه نسخه آزمایشی وجود دارد. MOSFET پیش فرض با مدل MbreakN یا MbreakN3 باید مشخصه‌هایی برای ولتاژ آستانه VTO و ثابت KP که برای یک شبیه‌سازی معنادار به مدل‌های ادوات PSpice اضافه شده است را داشته باشد. پایگاه اینترنتی شرکت‌های سازنده قطعات همچون "International Rectifier" به آدرس www.irf.com دارای مدل‌های آماده SPICE برای محصولات خود هستند.

✓ ترانزیستورها در PSpice باید دارای مدارهای راه‌انداز باشند. در صورتی که رفتار یک مدار راه‌انداز مشخص مورد نظر نباشد می‌توان آن را ایده‌آل در نظر گرفت. شبیه‌سازی‌های دارای MOSFET می‌توانند مدار راه‌اندازی شبیه شکل ۱-۳ داشته باشند. منبع ولتاژ VPULSE، ولتاژ گیت - سورس MOSFET را برای روشن و خاموش کردن آن اعمال می‌کند. ممکن است مقاومت گیت مورد نیاز نباشد، اما وجود آن از بروز مشکلات واگرایی عددی جلوگیری می‌کند.

VPULSE

V1 = 0

V2 = 12

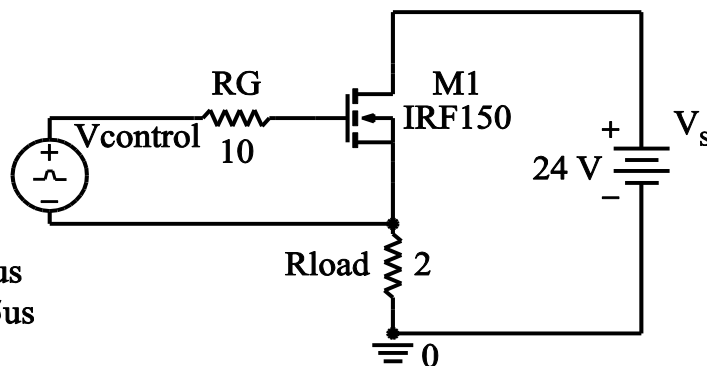
TD = 0

TR = 1n

TF = 1n

PW = 10us

PER = 25us



شکل ۱-۳- مدار راه‌انداز یک MOSFET ایده‌آل در Pspice.

□ هنگام نوشتن معادلات در یک مدار الکترونیک قدرت، معمولاً دیود به صورت ایده آل فرض می شود که این فرض فقط زمانی درست است که ولتاژهای مدار نسبت به افت ولتاژ مستقیم دیود در حالت هدایت بسیار بیشتر باشند. جریان دیود توسط معادله زیر وابسته به ولتاژ آن است:

$$i_d = I_s e^{v_d/nV_t} - 1$$

✓ که n ضریب انتشار با مقدار پیش فرض یک است. در PSpice با تنظیم n در یک مقدار کوچک چون 0.1 یا 0.01 می توان یک دیود ایده آل را تقریب زد. یک دیود تقریباً ایده آل با قطعه Dbreak با مدل PSpice زیر مدل سازی می شود:

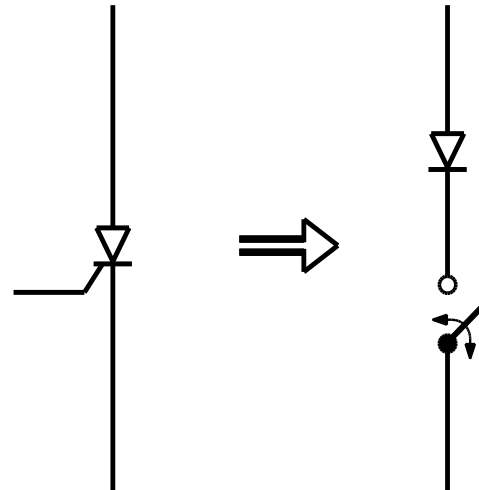
model Dbreak D n= 0.001

✓ با در نظر گرفتن مدل دیود ایده آل، نتایج شبیه سازی با نتایج تحلیلی که از معادلات توصیف کننده به دست می آید، یکسان خواهد بود. یک مدل PSpice برای دیود که به صورت دقیق تری رفتار آن را مدل کند را می توان از کتابخانه ادوات به دست آورد. شبیه سازی با مدل مفصل دیود نتایج واقعی تری را نسبت به مدل ایده آل ایجاد می کند. اگر ولتاژهای مدار بزرگ باشند تفاوت معناداری بین جواب ها، هنگام استفاده از مدل ایده آل و استفاده از مدل دقیق دیود دیده نخواهد شد. مدل پیش فرض دیود برای Dbreak را می توان به عنوان یک حالت میانی بین دیود ایده آل و دیود واقعی در نظر گرفت، که اغلب تفاوت ناچیزی در نتایج ایجاد خواهد کرد.

تایریستورها (SCRها)

□ یک مدل SCR در کتابخانه ادوات نسخه آزمایشی PSpice وجود دارد که می‌توان از آن برای شبیه‌سازی مدارهای دارای SCR استفاده کرد. اما این مدل دارای تعداد نسبتاً زیادی از مؤلفه‌ها است که موجب تحمیل یک محدوده ابعادی به نسخه آزمایشی PSpice می‌شود.

✓ یک مدل ساده SCR که در چندین مدار از این کتاب مورد استفاده قرار گرفته، یک کلید سری شده با یک دیود می‌باشد که در شکل ۴-۱ نمایش داده شده است. بستن کلید کنترل شده با ولتاژ، معادل اعمال جریان گیت به SCR است و دیود مانع از جاری شدن جریان معکوس در مدل می‌شود. اشکال اساسی این مدل ساده از SCR در این است که در کل دوره روشن بودن SCR، کلید کنترل شده با ولتاژ باید بسته بماند، که این مسئله نیازمند یک دانش اولیه از رفتار مداری است که از این قطعه استفاده می‌کند. توضیحات بیشتر، در مثال‌های PSpice، در فصول آتی ارائه می‌شود.



شکل ۴-۱- مدل ساده شده تایریستور (SCR) برای PSpice.

۱-۳- مشکلات همگرایی در PSpice

□ بعضی از شبیه‌سازی‌های PSpice در این کتاب، به‌خاطر کلیدزنی که در مدارهای شامل القاگر یا خازن انجام می‌پذیرد، دچار مشکلات همگرایی عددی می‌شوند. تمام فایل‌های PSpice که ارائه شده است به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دچار مشکلات همگرایی نشوند. اما گاهی تغییر یک متغیر مداری باعث ایجاد خطا در همگرایی تحلیل حالت گذار می‌شود.

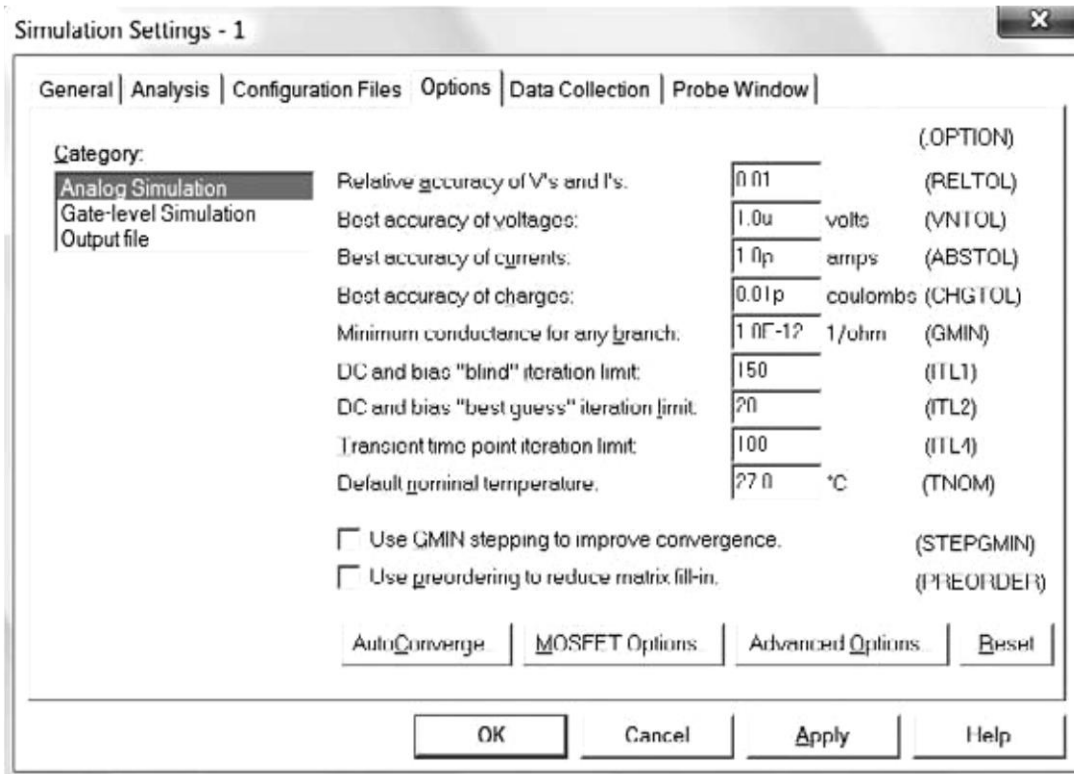
✓ در شرایطی که مشکل همگرایی در PSpice رخ می‌دهد تمهیدات زیر می‌تواند مفید باشد:

۱- حد تکرار ITL4 را از ۱۰ به ۱۰۰ یا بزرگ‌تر افزایش دهید. این یک انتخاب است که از پنجره تنظیم‌های شبیه‌سازی، همان‌گونه که در شکل ۱-۵ نشان داده شده، قابل دسترسی می‌باشد.

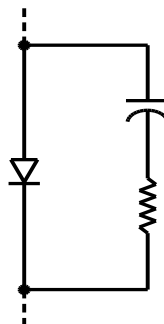
۲- تولرانس نسبی RELTOL را به مقداری غیر از مقدار پیش‌فرض ۰/۰۰۱ تغییر دهید (شکل ۱-۵).

۳- مدل قطعه را به‌گونه‌ای تغییر دهید که کمتر به مدل ایده‌آل نزدیک باشد. برای مثال، مقاومت هدایت یک کلید کنترل‌شده با ولتاژ را به مقدار بزرگ‌تری تغییر دهید، و یا از یک منبع ولتاژ کنترل‌شده که تغییرات ناگهانی ندارد استفاده کنید. اگر عدد n در مدل یک دیود افزایش یابد، از حالت ایده‌آل دور می‌شود. در حالت کلی مدل ادوات ایده‌آل، موجب بروز مشکلات همگرایی بیشتری نسبت به مدل‌های واقعی می‌شوند.

۴- از یک مدار ضربه‌گیر (Snubber) از نوع RC استفاده کنید. به‌منظور جلوگیری از تغییر شدید ولتاژ دو سر کلیدها، می‌توان یک مقاومت و خازن سری‌شده با ثابت زمانی کم را به‌صورت موازی با آنها قرار داد. برای مثال، قراردادن یک ترکیب سری از یک مقاومت $1k\Omega$ و یک خازن $1nF$ به‌صورت موازی با دیود (شکل ۱-۶) ممکن است باعث بهبود همگرایی شود بدون این که تأثیری بر نتایج شبیه‌سازی داشته باشد.



شکل ۱-۵- منوی انتخاب‌ها برای تنظیم‌هایی که می‌توانند مشکلات همگرایی را حل نمایند. RELTOL و ITL4 در اینجا تغییر کرده‌اند.



شکل ۱-۶- مدار RC برای کمک به همگرایی در PSpice.